

- **情報通信研究機構光デバイス技術センター利用の共同研究の公募について**
 - **平成16年11月11日**
-

情報通信研究機構(理事長:長尾 真)基礎先端部門所属の光デバイス技術センター(小金井本部、〒184-8795東京都小金井市貫井北町4-2-1)を利用する共同研究の公募を行います。

光デバイス技術センターは、情報通信のための光デバイス研究開発拠点として、2004年2月に整備されたもので、次世代の情報通信システムの鍵となる光デバイス試作研究を一貫して行うことができる装置(別紙参照)を揃えています。情報通信研究機構基礎先端部門では、今年度より、光デバイス技術センターを利用して情報通信のためのデバイス開発に関する共同研究の公募を行います。

公募を希望されるかたは、下記光デバイス技術センターのホームページ内の共同研究公募に関する記載に従って応募してください。応募された共同研究は、光デバイス技術センターの運営調整連絡会において審査を行い、共同研究実施の諾否を決定します。共同研究を行うこととなった課題については、情報通信研究機構との間で共同研究契約を締結して共同研究を開始します。光デバイス技術センター共同研究公募についてのお問い合わせも以下のホームページをご参照下さい。

光デバイス技術センター: <http://www2.nict.go.jp/ks/d316/>

<問い合わせ先>	<共同研究公募に関する問い合わせ先>
総務部広報室	基礎先端部門
大崎祐次	板部敏和
大野由樹子	TEL: 042-327-7546
Tel: 042-327-6923	FAX: 042-327-6799
Fax: 042-327-7587	

別紙

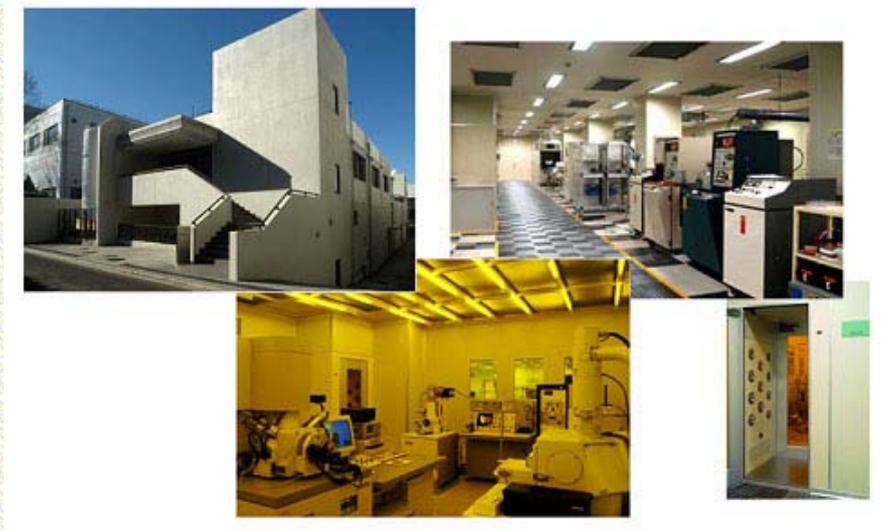
光デバイス技術センター

光デバイス技術センターでは、産学官の連携を強化することにより、より柔軟な発想のもとに、より豊かな成果を挙げることを目指し、また同時に施設・設備の一層の有効利用を計るため、広く共同研究を公募致します。

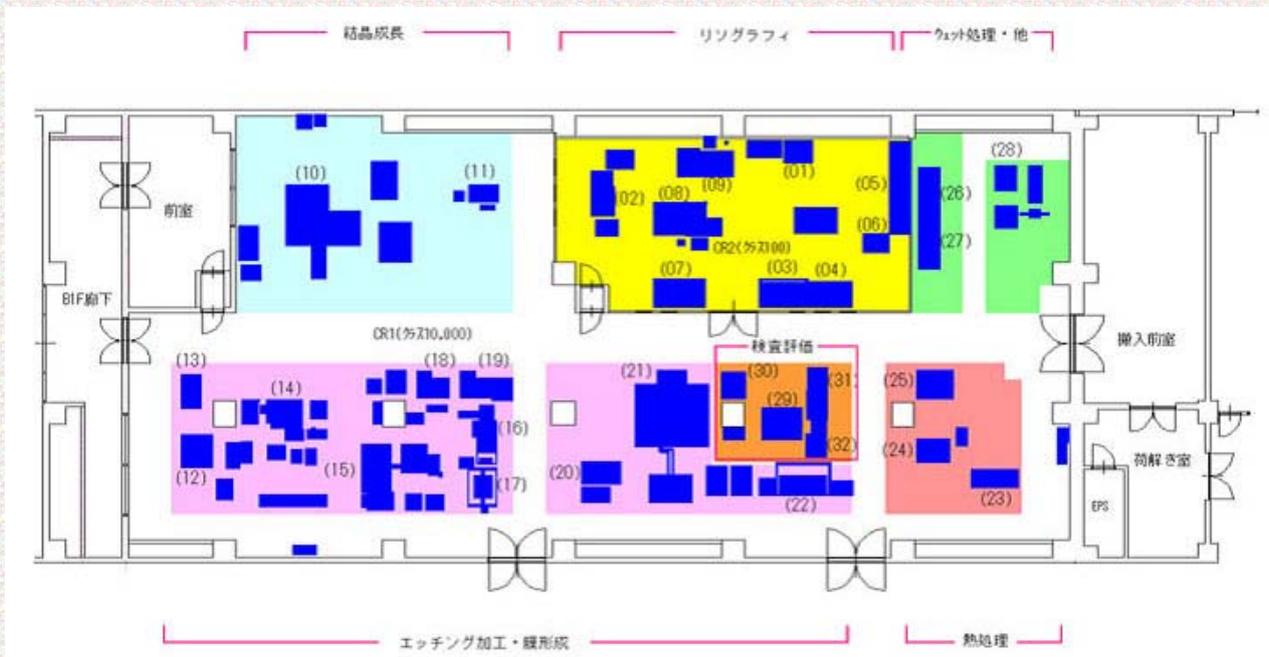
光デバイス技術センターは、情報通信研究機構(略称:NICT)において、情報通信のための光デバイスに関する研究開発を推進するために設立した研究施設です。設置している様々な設備や装置は、常に良い状態で使用できるよう、保守管理に十分な努力を払っております。

NICTで実施する共同研究は、共同研究契約を結ぶ双方が、共通の研究目標に向けて対等な立場で協力して研究を進めるもので、成果や知的所有権の取扱い、守秘義務などについても対応できる範囲で最大限配慮致します。

光デバイス技術センター



クリーンルーム(地下一階)



測定室, 事務室(一階)



光デバイス開発用プロセス装置

光デバイス開発用プロセス装置

[リソグラフィ]

- 1 UV露光装置
- 2 EB描画装置
- 3 レジスト塗布装置
- 4 レジストベーク炉
- 5 酸・有機処理ドラフトベンチ
- 6 リフトオフ処理ドラフトベンチ
- 7 非接触膜厚測定器
- 8 集束イオンビーム装置
- 9 走査電子顕微鏡

[半導体エピタキシ]

- 10 MBE成長装置

[材料・デバイス評価]

- 29 段差測定器
- 30 自動エリブソメータ
- 31 渦電流式抵抗測定器
- 32 四探針式抵抗測定器

- 33 PL測定装置
- 34 走査電子顕微鏡
- 35 原子間力顕微鏡
- 36 調芯装置・ボンダー

[材料・基板処理]

- 11 ランプ加熱装置
- 12 プラズマアッシャー
- 13 液体ソースプラズマCVD装置
- 14 ECRドライエッチング装置
- 15 反応性イオンエッチング装置

- 16 抵抗加熱蒸着装置
- 17 抵抗加熱蒸着装置
- 18 電子ビーム蒸着装置
- 19 電子ビーム蒸着装置
- 20 電子ビーム蒸着装置

- 21 スパッタ蒸着装置

- 22 電解メッキ装置

- 23 熱拡散炉
- 24 合金処理装置
- 25 急速熱処理装置

- 26 酸処理ドラフトベンチ
- 27 有機処理ドラフトベンチ
- 28 自動ダイシング装置

環境設備(地下一階、屋上、屋外)

